

Spezifikationen	
Teilenummer	1N4449
Hersteller	Microsemi
Beschreibung	DIODE GEN PURP 75V 200MA DO35
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter
Teilstatus	16500 pcs Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1V @ 30mA
Spannung - Sperr (Vr) (max)	75V
Supplier Device-Gehäuse	DO-35
Geschwindigkeit	Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed
Serie	-
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	4ns
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	DO-204AH, DO-35, Axial
Betriebstemperatur - Anschluss	-65°C ~ 150°C
Befestigungsart	Through Hole
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	25nA @ 20V
Strom - Richt (Io)	200mA
Kapazität @ Vr, F	-

sein:

1N4449 BK
Central Semiconductor Corp
DIODE GEN PURP 100V 150MA
DO35



1N4448_T50A
Fairchild/ON Semiconductor
DIODE GEN PURP 100V 200MA
DO35





 Not Actual Photo
 YIC International Co., Limited.

1N4453
 SUNMATE
 1N4453 SUNMATE



Not Actual Photo
YIC International Co., Limited.

1N4452
SUNMATE
1N4452 SUNMATE



1N4448_1T50R
Fairchild/ON Semiconductor
DIODE GEN PURP 100V 200MA
DO35



YIC International Co., Limited.

1N4450
SUNMATE
1N4450 SUNMATE



Schlüsselwort

Contact us: **Info@YIC-Electronics.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2023 YIC-Electronics.com - YIC International Co., Limited